

JXCCSP4953 P 沟道功率 MOSFET

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低导通电阻
- (3) 快速开关
- (4) 高输入阻抗
- (5) 驱动功率小

外形封装:



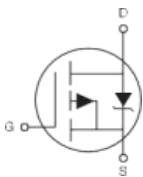
SMD-0.2

JXCCSP4953

$I_D: 7A$

$R_{DS(ON)}: 0.1\Omega$

$BV_{DSS}: 30V$



电特性: $T_j=25^{\circ}C$

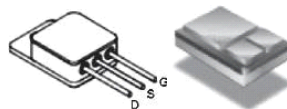
		MI N	TYP	MAX	UNIT S	测试条件
BV_{DSS}	漏源击穿电压	30	—	—	V	$V_{GS} = 0V, I_D = 250\mu A$
$R_{DS(on)}$	静态漏源导通电阻	—	—	0.65	Ω	$V_{GS} = 10V, I_D = 7A$
		—	—	0.1	Ω	$V_{GS} = 4.5V, I_D = 7A$
$V_{GS(th)}$	阈值电压	1	—	3	V	$V_{DS} = V_{GS}, I_D = 250\mu A$
I_{DSS}	零栅电压漏电流	—	—	25	μA	$V_{DS} = 30V, V_{GS} = 0V$
		—	—	250		$V_{DS} = 24V, V_{GS} = 0V, T_j = 125^{\circ}C$
I_{GSS}	栅源正向漏电流	—	—	100	nA	$V_{GS} = 20V$
I_{GSS}	栅源反相漏电流	—	—	-100		$V_{GS} = -20V$

JXCCSP3012 P 沟道功率 MOSFET

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低导通电阻
- (3) 快速开关
- (4) 高输入阻抗
- (5) 驱动功率小

外形封装:



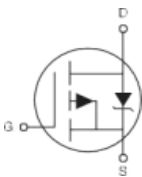
TO-257 SMD-0.5

JXCCSP3012

$I_D: 12A$

$R_{DS(ON)}: 0.035\Omega$

$BV_{DSS}: 30V$



电特性: $T_j=25^{\circ}C$

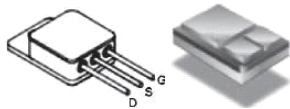
		MI N	TYP	MAX	UNIT S	测试条件
BV_{DSS}	漏源击穿电压	30	—	—	V	$V_{GS} = 0V, I_D = 250\mu A$
$R_{DS(on)}$	静态漏源导通电阻	—	—	0.02	Ω	$V_{GS} = 10V, I_D = 12A$
		—	—	0.035	Ω	$V_{GS} = 4.5V, I_D = 12A$
$V_{GS(th)}$	阈值电压	1	—	3	V	$V_{DS} = V_{GS}, I_D = 250\mu A$
I_{DSS}	零栅电压漏电流	—	—	25	μA	$V_{DS} = 30V, V_{GS} = 0V$
		—	—	250		$V_{DS} = 24V, V_{GS} = 0V, T_j = 125^{\circ}C$
I_{GSS}	栅源正向漏电流	—	—	100	nA	$V_{GS} = 20V$
I_{GSS}	栅源反相漏电流	—	—	-100		$V_{GS} = -20V$

JXCCSP3025 P 沟道功率 MOSFET

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低导通电阻
- (3) 快速开关
- (4) 高输入阻抗
- (5) 驱动功率小

外形封装:



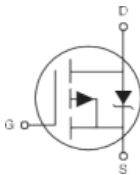
TO-257 SMD-0.5

JXCCSP3025

$I_D: 25A$

$R_{DS(ON)}: 0.086\Omega$

$BV_{DSS}: 30V$



电特性: $T_j=25^{\circ}C$

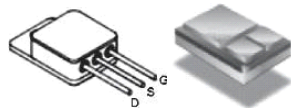
		MI N	TYP	MAX	UNIT S	测试条件
BV_{DSS}	漏源击穿电压	30	—	—	V	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$
$R_{DS(on)}$	静态漏源导通电阻	—	—	0.05	Ω	$V_{GS}=10V, I_D=25A$
		—	—	0.086	Ω	$V_{GS}=5V, I_D=25A$
$V_{GS(th)}$	阈值电压	1	—	3	V	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=250\mu A$
I_{DSS}	零栅电压漏电流	—	—	25	μA	$V_{DS}=30V, V_{GS}=0V$
		—	—	250		$V_{DS}=24V, V_{GS}=0V, T_j=125^{\circ}C$
I_{GSS}	栅源正向漏电流	—	—	100	nA	$V_{GS}=20V$
I_{GSS}	栅源反相漏电流	—	—	-100		$V_{GS}=-20V$

JXCCSP3040 P 沟道功率 MOSFET

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低导通电阻
- (3) 快速开关
- (4) 高输入阻抗
- (5) 驱动功率小

外形封装:



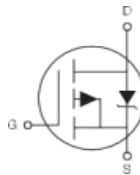
TO-254 SMD-1.0

JXCCSP3040

$I_D: 40A$

$R_{DS(ON)}: 0.037\Omega$

$BV_{DSS}: 30V$



电特性: $T_j=25^{\circ}C$

		MI N	TYP	MAX	UNIT S	测试条件
BV_{DSS}	漏源击穿电压	30	—	—	V	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$
$R_{DS(on)}$	静态漏源导通电阻	—	—	0.02	Ω	$V_{GS}=10V, I_D=40A$
		—	—	0.037	Ω	$V_{GS}=4.5V, I_D=40A$
$V_{GS(th)}$	阈值电压	1	—	3	V	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=250\mu A$
I_{DSS}	零栅电压漏电流	—	—	25	μA	$V_{DS}=30V, V_{GS}=0V$
		—	—	250		$V_{DS}=24V, V_{GS}=0V, T_j=125^{\circ}C$
I_{GSS}	栅源正向漏电流	—	—	100	nA	$V_{GS}=20V$
I_{GSS}	栅源反相漏电流	—	—	-100		$V_{GS}=-20V$

JXCCSP6005 P 沟道功率 MOSFET

特性:

(1) 标准封装

(2) 低导通电阻

(3) 快速开关

(4) 高输入阻抗

(5) 驱动功率小

外形封装:



SMD-0.2

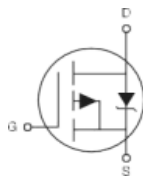
JXCCSP6005

$I_D: 5A$

$R_{DS(ON)}: 0.2\Omega$

$BV_{DSS}: 60V$

电特性: $T_j=25^{\circ}C$



		MI N	TYP	MAX	UNIT S	测试条件
BV_{DSS}	漏源击穿电压	60	—	—	V	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$
$R_{DS(on)}$	静态漏源导通电阻	—	—	0.165	Ω	$V_{GS}=10V, I_D=5A$
		—	—	0.2	Ω	$V_{GS}=4.5V, I_D=5A$
$V_{GS(th)}$	阈值电压	1	—	3	V	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=250\mu A$
I_{DSS}	零栅电压漏电流	—	—	25	μA	$V_{DS}=60V, V_{GS}=0V$
		—	—	250		$V_{DS}=48V, V_{GS}=0V, T_j=125^{\circ}C$
I_{GSS}	栅源正向漏电流	—	—	100	nA	$V_{GS}=20V$
I_{GSS}	栅源反相漏电流	—	—	-100		$V_{GS}=-20V$

JXCCSP6010 P 沟道功率 MOSFET

特性:

(1) 标准封装

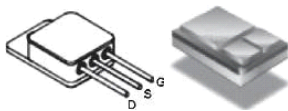
(2) 低导通电阻

(3) 快速开关

(4) 高输入阻抗

(5) 驱动功率小

外形封装:



TO-257 SMD-0.5

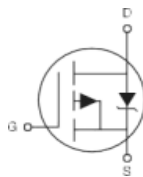
JXCCSP6010

$I_D: 10A$

$R_{DS(ON)}: 0.085\Omega$

$BV_{DSS}: 60V$

电特性: $T_j=25^{\circ}C$



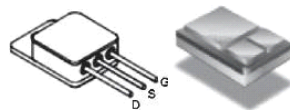
		MI N	TYP	MAX	UNIT S	测试条件
BV_{DSS}	漏源击穿电压	60	—	—	V	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$
$R_{DS(on)}$	静态漏源导通电阻	—	—	0.06	Ω	$V_{GS}=10V, I_D=10A$
		—	—	0.085	Ω	$V_{GS}=4.5V, I_D=10A$
$V_{GS(th)}$	阈值电压	0.8	—	2.5	V	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=250\mu A$
I_{DSS}	零栅电压漏电流	—	—	25	μA	$V_{DS}=60V, V_{GS}=0V$
		—	—	250		$V_{DS}=48V, V_{GS}=0V, T_j=125^{\circ}C$
I_{GSS}	栅源正向漏电流	—	—	100	nA	$V_{GS}=20V$
I_{GSS}	栅源反相漏电流	—	—	-100		$V_{GS}=-20V$

JXCCSP6018 P 沟道功率 MOSFET

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低导通电阻
- (3) 快速开关
- (4) 高输入阻抗
- (5) 驱动功率小

外形封装:



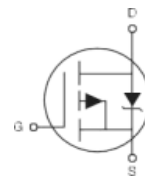
TO-257 SMD-0.5

JXCCSP6018

$I_D : 18A$

$R_{DS(ON)} : 0.04 \Omega$

$BV_{DSS} : 60V$



电特性: $T_j = 25^\circ C$

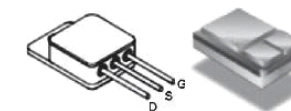
		MI N	TYP	MAX	UNIT S	测试条件
BV_{DSS}	漏源击穿电压	60	—	—	V	$V_{GS} = 0V, I_D = 250 \mu A$
$R_{DS(on)}$	静态漏源导通电阻	—	—	0.03	Ω	$V_{GS} = 10V, I_D = 18A$
		—	—	0.04	Ω	$V_{GS} = 4.5V, I_D = 18A$
$V_{GS(th)}$	阈值电压	0.8	—	2.5	V	$V_{DS} = V_{GS}, I_D = 250 \mu A$
I_{DSS}	零栅电压漏电流	—	—	25	μA	$V_{DS} = 60V, V_{GS} = 0V$
		—	—	250		$V_{DS} = 48V, V_{GS} = 0V, T_j = 125^\circ C$
I_{GSS}	栅源正向漏电流	—	—	100	nA	$V_{GS} = 20V$
I_{GSS}	栅源反相漏电流	—	—	-100		$V_{GS} = -20V$

JXCCSP6030 P 沟道功率 MOSFET

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低导通电阻
- (3) 快速开关
- (4) 高输入阻抗
- (5) 驱动功率小

外形封装:



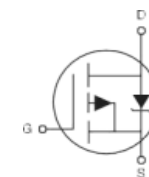
TO-254 SMD-1.0

JXCCSP6030

$I_D : 30A$

$R_{DS(ON)} : 0.035 \Omega$

$BV_{DSS} : 60V$



电特性: $T_j = 25^\circ C$

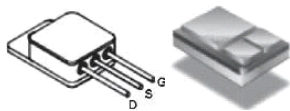
		MI N	TYP	MAX	UNIT S	测试条件
BV_{DSS}	漏源击穿电压	60	—	—	V	$V_{GS} = 0V, I_D = 250 \mu A$
$R_{DS(on)}$	静态漏源导通电阻	—	—	0.03	Ω	$V_{GS} = 10V, I_D = 30A$
		—	—	0.035	Ω	$V_{GS} = 4.5V, I_D = 30A$
$V_{GS(th)}$	阈值电压	1	—	3	V	$V_{DS} = V_{GS}, I_D = 250 \mu A$
I_{DSS}	零栅电压漏电流	—	—	25	μA	$V_{DS} = 60V, V_{GS} = 0V$
		—	—	250		$V_{DS} = 48V, V_{GS} = 0V, T_j = 125^\circ C$
I_{GSS}	栅源正向漏电流	—	—	100	nA	$V_{GS} = 20V$
I_{GSS}	栅源反相漏电流	—	—	-100		$V_{GS} = -20V$

JXCCSP6045 P 沟道功率 MOSFET

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低导通电阻
- (3) 快速开关
- (4) 高输入阻抗
- (5) 驱动功率小

外形封装:



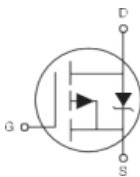
TO-254 SMD-1.0

JXCCSP6045

$I_D: 45A$

$R_{DS(ON)}: 0.04\ \Omega$

$BV_{DSS}: 60V$



电特性: $T_j=25^\circ C$

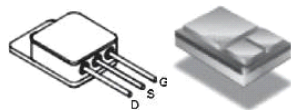
		MI N	TYP	MAX	UNIT S	测试条件
BV_{DSS}	漏源击穿电压	60	—	—	V	$V_{GS} = 0V, I_D = 250\ \mu A$
$R_{DS(on)}$	静态漏源导通电阻	—	—	0.03	Ω	$V_{GS} = 10V, I_D = 4A$
		—	—	0.04	Ω	$V_{GS} = 4.5V, I_D = 45A$
$V_{GS(th)}$	阈值电压	1	—	3	V	$V_{DS} = V_{GS}, I_D = 250\ \mu A$
I_{DSS}	零栅电压漏电流	—	—	25	μA	$V_{DS} = 60V, V_{GS} = 0V$
		—	—	250		$V_{DS} = 48V, V_{GS} = 0V, T_j = 125^\circ C$
I_{GSS}	栅源正向漏电流	—	—	100	nA	$V_{GS} = 20V$
I_{GSS}	栅源反相漏电流	—	—	-100		$V_{GS} = -20V$

JXCCSP1018 P 沟道功率 MOSFET

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低导通电阻
- (3) 快速开关
- (4) 高输入阻抗
- (5) 驱动功率小

外形封装:



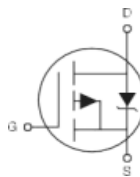
TO-257 SMD-0.5

JXCCSP1018

$I_D: 18A$

$R_{DS(ON)}: 0.145\ \Omega$

$BV_{DSS}: 100V$



电特性: $T_j=25^\circ C$

		MI N	TYP	MAX	UNIT S	测试条件
BV_{DSS}	漏源击穿电压	100	—	—	V	$V_{GS} = 0V, I_D = 250\ \mu A$
$R_{DS(on)}$	静态漏源导通电阻	—	—	0.145	Ω	$V_{GS} = 10V, I_D = 18A$
		—	—	—	—	—
$V_{GS(th)}$	阈值电压	2	—	4	V	$V_{DS} = V_{GS}, I_D = 250\ \mu A$
I_{DSS}	零栅电压漏电流	—	—	25	μA	$V_{DS} = 100V, V_{GS} = 0V$
		—	—	250		$V_{DS} = 80V, V_{GS} = 0V, T_j = 125^\circ C$
I_{GSS}	栅源正向漏电流	—	—	100	nA	$V_{GS} = 20V$
I_{GSS}	栅源反相漏电流	—	—	-100		$V_{GS} = -20V$

JXCCSP1035 P 沟道功率 MOSFET

特性:

(1) 标准封装

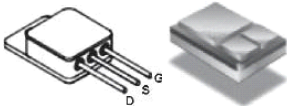
(2) 低导通电阻

(3) 快速开关

(4) 高输入阻抗

(5) 驱动功率小

外形封装:



TO-254 SMD-1.0

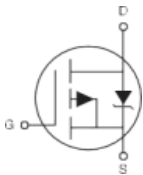
JXCCSP1035

$I_D: 35A$

$R_{DS(ON)}: 0.06\Omega$

$BV_{DSS}: 100V$

电特性: $T_j=25^{\circ}C$



		MI N	TYP	MAX	UNIT S	测试条件
BV_{DSS}	漏源击穿电压	100	—	—	V	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$
$R_{DS(on)}$	静态漏源导通电阻	—	—	0.045	Ω	$V_{GS}=10V, I_D=35A$
		—	—	0.06	Ω	$V_{GS}=4.5V, I_D=35A$
$V_{GS(th)}$	阈值电压	2	—	4	V	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=250\mu A$
I_{DSS}	零栅电压漏电流	—	—	25	μA	$V_{DS}=100V, V_{GS}=0V$
		—	—	250		$V_{DS}=80V, V_{GS}=0V, T_j=125^{\circ}C$
I_{GSS}	栅源正向漏电流	—	—	100	nA	$V_{GS}=20V$
I_{GSS}	栅源反相漏电流	—	—	-100		$V_{GS}=-20V$